

附件一

太陽光電模組產品登錄申請表

申請日期： 年 月 日

公司名稱		統一編號	
負責人		聯絡人	
電子信箱		聯絡電話	
聯絡地址			
廠牌		申請件數	
模組製造廠場	(請詳細填寫完整地址)		
電池片製造廠場	(請詳細填寫完整地址)		
檢具證明文件說明			
性能	驗證依據標準		
	驗證單位		
	測試實驗室		
	證書有效期限		
安全	驗證依據標準		
	驗證單位		
	測試實驗室		
	證書有效期限		
電位導致衰減	驗證依據標準		
	驗證單位		
	測試實驗室		
	證書有效期限		
鹽霧腐蝕	驗證依據標準		
	驗證單位		
	測試實驗室		
	證書有效期限		
備註	申請時應按每份證書檢附下列樣品及數量： (一) 申請登錄之太陽光電模組，數量三片。 (二) 登錄模組採用之太陽電池，須為同製造廠場，數量五片。 符合本部標準檢驗局所訂之「台灣高效能太陽光電模組技術規範」且取得證明者，得免附樣品。		

(請於此處蓋申請人公司章及負責人印章)

附件二

附件二

依法營運聲明書

立聲明書人 _____ 公司，謹此切結保證本公司為依據中華民國公司法有效登記之合法公司，並依法進行營運及完納所有稅捐。倘因違反本聲明書所保證之內容，立聲明書人願意擔負起所有相關法律責任。

此致

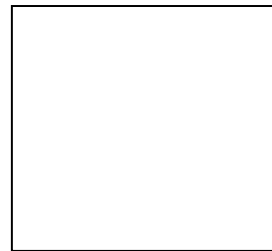
經濟部能源署

公司名稱：

統一編號：

公司地址：

代表人：



中 華 民 國 年 月 日

廠商展延申請書

申請人_____公司切結保證本申請之太陽光電模組產品與其先前登錄時所提交之驗證標準、驗證證書及驗證報告書，以及現有之登錄資訊均相符，特此聲明。

太陽光電模組產品登錄資訊內容：

- (一) 登錄申請人。
- (二) 生產地。
- (三) 廠牌。
- (四) 型號。
- (五) 尺寸。
- (六) 額定輸出功率。
- (七) 效率。
- (八) 取得性能驗證所適用之驗證標準及驗證單位。
- (九) 取得安全驗證所適用之驗證標準及驗證單位。
- (十) 其他產品備註事項。
- (十一) 主管機關認有必要加註之事項。
- (十二) 產品登錄之有效期間。
- (十三) 所提具各項證書與報告之有效期間。
- (十四) 曾提出申請核可之歷史資料。
- (十五) 登錄項目異動資訊。

倘因違反本申請書所保證之內容，本申請人願意擔負起所有相關法律責任。

謹 此

公司名稱： (蓋章)

代 表 人： (蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

附表一

太陽光電模組產品效率規格表

年度		111 年	112 年	113 年	114 年	115 年
矽晶類	模組面積	17.0 %	17.5 %	18.0 %	18.5 %	19.0 %
	電池面積	19.5 %	20.0 %	20.5 %	21.0 %	21.5 %
薄膜類	模組面積	9.5 %	10.0 %	10.0 %	10.5 %	10.5 %
	電池面積	10.5 %	11.0 %	11.0 %	11.5 %	11.5 %

備註:

1. 110 年起新增電池面積效率規格欄位，電池效率申請方式：模組產品具有特殊用途者，除須依照太陽光電模組產品登錄作業要點提出申請外，經審查委員判定是否具有特殊用途，始得採用附表一之電池效率作為模組產品效率門檻。
2. 模組面積效率(%)=額定輸出功率(W)/模組外框面積(m²) / 1,000 W·m⁻² × 100 %，採無條件捨去法，取至小數點後第一位。
3. 電池面積效率(%)=額定輸出功率(W)/模組內電池面積總和(m²) / 1,000 W·m⁻² × 100 %，採無條件捨去法，取至小數點後第一位。

附表二

太陽光電模組產品性能驗證標準表

產品類型	驗證依據標準（應依產品類型採下列標準項目之一）
矽晶型	1. CNS 15114 2. CNS 61215-1：2022、CNS 61215-1-1：2023、CNS 61215-2：2022 3. IEC 61215-1：2016、IEC 61215-1-1：2016、IEC 61215-2：2016
薄膜型	1. CNS 15115 2. CNS 61215-1：2022、CNS 61215-1-4：2023、CNS 61215-2：2022 3. IEC 61215-1：2016、IEC 61215-1-2：2016、IEC 61215-1-3：2016、IEC 61215-1-4：2016、IEC 61215-2：2016

備註：以上標準所列年版或更新版

附表三

太陽光電模組產品安全驗證標準表

	驗證依據標準（應採下列標準項目之一）
所有類型 模組產品	1. CNS 15118-1 及 CNS 15118-2 2. IEC 61730-1：2016 及 IEC 61730-2：2016

備註：以上標準所列年版或更新版

附表四

電位導致衰減（PID）試驗

	參考依據標準（應依產品類型採下列標準項目之一）
矽晶型	1. CNS 61215-1：2022、CNS 61215-1-1：2023、CNS 61215-2：2022 2. IEC 61215-1：2021、IEC 61215-1-1：2021、IEC 61215-2：2021
薄膜型	1. CNS 61215-1：2022、CNS 61215-1-4：2023、CNS 61215-2：2022 2. IEC 61215-1：2021、IEC 61215-1-2：2021、IEC 61215-1-3：2021、IEC 61215-1-4：2021、IEC 61215-2：2021

備註：以上標準所列年版或更新版

鹽霧腐蝕試驗

	參考依據標準（應採下列標準項目之一）
所有類型 模組產品	1. IEC 61701：2020 2. CNS 15196：2023

備註：以上標準所列年版或更新版